В первом столбце даны величиы расщепления в условных единицах, при этом величина 0,001 соответствует значению напряженности поля 52 Э. Во второй строке даны наборы логарифмов сил осцилляторов, для которых приведены расчеты положения максимумов f в миллиангстремах. Реальные значения lg(gf) составляют для линии 630,25 нм -1,24, а для линии 630,15 нм lg(gf) = -0,94. Остальные данные для различных lg(gf) приведены для оценки влияния коэффициента поглощения на положение максимумов *f* в реальной атмосфере. Мы видим, что при изменении величины поля в 20 раз – от 52 до 1040 Э – изменение расстояния максимума f от центра линии не превышает 50 %. Изменение gf линии 630,15 в 8 раз может приводить к различиям до 30 %. Таким образом, мы видим, что для реальной атмосферы положение максимумов величин f и s все-таки зависит от H и  $\eta_0$ , однако зависимость эта слаба и формулы (17) и (18) в значительной мере отражают картину и для реальной атмосферы. Несомненно, что расчеты должны проводиться для каждого конкретного случая сравнения величин магнитных полей в разных линиях.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Баранов А.В. Поведение экстремумов профилей Стокса магнитоактивных линий в спокойной солнечной фотосфере // Солнечная активность и ее влияние на Землю. Владивосток: Дальнаука, 2005. С. 3-14. (Тр.УАФО; т.8, вып. 8).

2. *Ельяшевич М. А.* Атомная и молекулярная спектроскопия. М.: Государственное издательство физ. – мат. литературы, 1962. 892 с.

3. Мустель Э. Р. Звездные атмосферы. М.: Государственное издательство физ. – мат. литературы, 1960. 444 с.

4. Kneer F. Line Profiles in Sunspots // Astron. and Astrophys. 1972. V.18, N 2. P. 39-47.

А.В. Баранов, Н.Н. Баранова, В.М. Григорьев

## ОЦЕНКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ТОКОВ И ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ СИЛ В РАЙОНЕ МАЛЫХ СОЛНЕЧНЫХ ВСПЫШЕК

Малые солнечные вспышки составляют подавляющее большинство явлений этого класса, т. е. именно они являются типичным процессом энерговыделения в атмосфере Солнца. Соответственно механизм вспышки прежде всего должен объяснить особенности малых и маломощных процессов этого типа.

В работе [2] А.В. Барановым и Н.Н. Барановой был подтвержден известный факт возгорания узлов микровспышек в  $H_{\alpha}$  вблизи нулевой линии продольного поля. Кроме того, было найдено, что возгорание вспышек происходит там, где близки к нулю градиенты вертикальных составляющих напряженности магнитного поля и электрического тока.

Целью данной работы было изучение особенностей электрических токов **j** и электромагнитных сил **F** в районах, непосредственно прилегающих к местам активной области (AO), где происходили малые солнечные вспышки.

Методика расчета **ј** и **F** приведена в работе [3] и вкратце сводится к следующему.

На некотором уровне *l* в атмосфере Солнца, где энергия магнитного поля много больше газового давления, можно принять, что магнитное поле близко к потенциальному. Тогда применим следующий метод расчета **j** и **F**.

Из уравнения  $div \mathbf{H} = 0$  имеем

$$\frac{\partial}{\partial}\frac{H_z}{z} = -\frac{\partial}{\partial}\frac{H_x}{x} - \frac{\partial}{\partial}\frac{H_y}{y}.$$

Следовательно, на высоте *l* получаем

$$H_z(l) = H_z(0) + \frac{\partial}{\partial} \frac{H_z}{z} l$$

Зная распределение  $H_z$  на уровне l и учитывая, что на этом уровне rot H=0, можно, используя решение задачи Дирихле, рассчитать структуру **H**.

Имея карту вектора магнитного поля на одном уровне и значения составляющих **H** на верхнем уровне, мы можем определить изменение **H** с высотой и рассчитать структуру электрических токов и электромагнитных сил.

Объектом исследования являлась активная область N 135 СД июня 1984 г., хорошо известная по итогам кооперативных программ наблюдений и отдельным исследованиям.

Материалом для исследования служили карты полного вектора магнитного поля, полученные в ИСЗФ СО РАН 23 июня 1984 г., H<sub>α</sub>фильтрограммы и фотогелиограммы Уссурийской астрофизической обсерватории ДВО РАН, а также материалы, опубликованные в работах [4–6]. Программы расчета разработаны в УАФО ДВО РАН.

Обстоятельства наблюдений (время получения карт магнитного поля, время и положение вспышек в активной области) подробно описаны нами в [1].

Основные результаты анализа таковы.

В дополнение к сведениям, приведенным в статье [2], следует отметить, что микровспышки, как правило, расположены в областях, где вертикальная компонента магнитного поля  $H_z$  не превышает 400Э для всей совокупности вспышек и не более 200 Э в местах их наибольшей концентрации (*рисунок*,  $\delta$ ). Напомним, что микровспышки располагаются в областях, прилегающих к нулевой линии  $H_z$ , но не совпадающих с ней. Примерно в половине случаев отмечено совпадение узлов микровспышек с локальными холмами продольной составляющей поля, что отмечалось нами в [3] для узлов крупной вспышки.

Отметим сразу, что приводимые ниже величины **j** и **F** выражены в относительных единицах (о. е.). Для значений электрического тока 1 о. е. =  $10^2$  единиц CGSE; для значений электромагнитной силы 1 о. е. =  $10^{-5}$  H/m<sup>2</sup>. Большая часть вспышечных узлов на картах расположена в областях **j**, соответствующих значениям 20–80 о. е. при максимальных значениях **j** = 200–500 о. е. Для всех изученных карт магнитного поля найдено, что отношения величин  $j_z/|j|$  для областей возгорания микровспышек составляет 0,1–0,3, т. е. вертикальная составляющая тока много меньше горизонтальных.

Максимальные значения **F**, отмеченные на рассмотренных картах, находятся в пределах 500–2200 о. е. а отношения  $F_z$ / **F**, как правило, составляют 0,3–0,5, т. е. вертикальная составляющая электромагнитной силы явно меньше горизонтальной.



Изолинии продольной составляющей магнитного поля для карты, полученной 23 июня 1984 г в 8:06–8:26 UT(а), соответствующие значениям поля 0, 200, 400, 800 Э, и пространственная плотность распределения микровспышек. Более темная площадка соответствует большей плотности (б). Максимальная плотность соответствует пятикратной повторяемости вспышек в данном месте

Области возгорания микровспышек соответствуют областям, где значения  $|\mathbf{j}| u | \mathbf{F} |$  избегают максимальных и минимальных значений. Примерно 2/3 случаев показывают, что микровспышки находятся в областях значительных горизонтальных градиентов величин  $|\mathbf{j}| u | \mathbf{F} |$ .

Помимо выявленной в [2] тенденции расположения вспышек вблизи указанных выше линий достаточно хорошо выявляется близость (не совпадение!) узлов микровспышек к нулевой линии вертикальной составляющей электромагнитной силы

$$F_{z} = 0.$$

Это хорошо заметно при сравнении *puc.1,а*, где пунктиром показаны нулевые линии  $F_z$  на карте для момента времени  $8^h06^m - 8^h26^m$ за 23.06.1984 г., и карты (б), на которой дана плотность распределения микровспышек по совокупности наблюдательных данных. Описанная картина является типичной для всего промежутка времени наблюдений, за которое было получено пять карт вектора магнитного поля и шесть случаев возгорания узлов микровспышек. Ввиду того что в формулы для определения **ј** и **F** входят производные от компонент магнитного поля, эти величины отягощены значительными ошибками. По этой причине не представляется возможным проследить динамику анализируемых величин. Нами рассмотрены и показаны в работе только те особенности, которые присутствуют на всех пяти картах.

Сравнивая результаты данной работы, [2] и [3], можно видеть, что микровспышки и крупная вспышка происходили областях АО, характеризуемых одним и тем же набором характеристик:

$$H_z = 0, \ dH_z/dz = 0, \ j_z = 0, \ F_z = 0.$$
 (1)

Следовательно, они должны описываться моделями, близкими по своей физической сущности.

И, наконец, нами рассмотрены особенности **j** и **F** в области без вспышек, находящейся внутри кольца, образованного микровпышками. В дополнение к изложенному в [2] необходимо отметить, что в 3 случаях из 5 в области находится колечко, образованное изолиние  $f_{z}$ .=0, а в двух других случаях отрезок изолинии  $f_{z}$ .=0 имеет

явно большую протяженность, чем в окружающих область площадок с микровспышками. Численные значения величин **j** и **F** в области без вспышек свидетельствуют о том, что в ней малы значения как  $F_z$ , так и **F** и их производных в горизонтальной плоскости.

Представляется интересным выяснить, возможны ли конфигурации поля, для которых указанный набор условий выполняется.

Плотность электрического тока рассчитывается по формуле

$$\mathbf{j} = rot \mathbf{H} \bullet c/4\pi. \tag{2}$$

Если имеются карты вектора магнитного поля **H** на двух уровнях солнечной атмосферы, то **j** определяется напрямую. Если имеется карта **H** на одном уровне, без дополнительных предположений о структуре **H** рассчитывается только вертикальная составляющая тока  $j_z$ .

Определение плотности электромагнитных сил проводится по формуле

$$\mathbf{F} = rot\mathbf{H} \cdot \mathbf{H}/4 \cdot \pi = \mathbf{j} \cdot \mathbf{H}/c, \qquad (3)$$

расчет по которой возможен при наличии карт **H** на двух уровнях атмосферы. К этим условиям необходимо добавить уравнение

$$\operatorname{div}\mathbf{H} = 0. \tag{4}$$

Зададим конфигурацию поля в следующем виде:  $\mathbf{H} = [H_x(y), 0, H_z(y)].$ 

Из (4) имеем условие

$$\frac{\partial}{\partial}\frac{Hx}{x} + \frac{\partial}{\partial}\frac{Hy}{y} + \frac{\partial}{\partial}\frac{Hz}{z} = 0,$$

которому заданная конфигурация удовлетворяет. Для составляющих электрического тока имеем

$$j_{x} = \frac{c}{4\pi} \frac{\partial}{\partial} \frac{Hz}{y},$$
$$j_{y} = 0,$$
$$j_{z} = \frac{c}{4\pi} \frac{\partial}{\partial} \frac{Hx}{y}.$$

В рассмотренной выше ситуации должно быть  $\frac{\partial}{\partial} \frac{Hz}{y} >> \frac{\partial}{\partial} \frac{Hx}{y}$ ,

т. е. неоднородность вертикальной составляющей магнитного поля в горизонтальной плоскости много больше, чем горизонтальной составляющей. Для составляющих электромагнитной силы получаем

$$F_{x} = 0,$$
  

$$F_{y} = \frac{1}{4\pi} \left(-\frac{\partial}{\partial} \frac{Hz}{y}H_{z} - \frac{\partial}{\partial} \frac{Hx}{y}H_{x}\right)$$
  

$$F_{z} = 0.$$

Ситуация довольно близка к той, которая получена при расчетах j и F, выполненных выше. Понятно, что можно подобрать и более реалистические конфигурации, описываемые соотношениями (1).

Подводя итоги работы, следует отметить, что полученные здесь результаты позволяют сделать определенные выводы о структуре магнитного поля и механизме вспышки.

Найдены особенности распределения **j** и **F**, подтверждающие гипотезу о том, что в результате микровспышки происходит некоторое изменение формы магнитной петли либо деформация поверхности токового слоя в данной области [7].

Данная работа выполнена частично в рамках Программы фундаментальных исследований Президиума РАН № 30 "Солнечная активность и физические процессы в системе Солнце – Земля".

## ЛИТЕРАТУРА

1. Баранов А.В., Григорьев В.М. Связь эволюции группы солнечных пятен и структуры электромагнитных сил // Структура и динамика солнечной короны: Тр. междунар. конф. по физике Солнца. Троицк, 1999. С. 26-31.

2. *Баранов А.В., Баранова Н.Н.* Особенности структуры магнитного поля в районе малых солнечных вспышек // Солнечная активность и её влияние на Землю. Владивосток: Дальнаука, 2002. С. 5-13. (Тр. УАФО; т. 7, вып. 7).

3. Баранов А.В., Корниенко Г.И. Процессы в активной области AR 5395 марта 1989 года и их связь с электрическими токами и электромагнитными силами // Солнечная активность и её влияние на Землю. Владивосток: Дальнаука, 2002. С. 17-28. (Труды УАФО; т. 6, вып. 6).

4. *Боровик А. В.* Малые солнечные вспышки в активной области №135 СД 23 июня 1984 г. // Астрон. циркуляр. 1985. № 1413. С. 2-4.

5. Боровик А. В., Григорьев В. М. и др. Эволюция активной области СД № 135 в июне 1984 г. и ее связь с крупномасштабными магнитными полями на Солнце // Тр. астрон. обсерватории Скалнате Плесо. 1986. Т. 15. С. 211-242.

6. Григорьев В. М., Селиванов В. Л. Структура и динамика конвективных движений в активной области во время ее возникновения и развития // Астрономический циркуляр. 1985. № 1412. С. 1-3.

7. Прист Э. Р. Солнечная магнитогидродинамика. М.: Мир. 1985. 592 с.